

SF 126 · SF 127 · SF 128 · SF 129

Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistoren für Breitbandverstärker und als mittelschneller Schalter

Bauform 1 TO39

Wärmewiderstand $R_{thja} \leq 0,29 \text{ K/mW}$
 $R_{thjc} \leq 0,07 \text{ K/mW}$

Grenzwerte gültig für den Betriebstemperaturbereich

	SF 126	SF 127	SF 128	SF 129
U_{CBO}	33 V	66 V	100 V	120 V
U_{CEO}	20 V	30 V	60 V	80 V
U_{EBO}		7 V		
I_C		500 mA		
I_{CM}		1 A		
I_B		250 mA		
P_{tot}		600 mW ($\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$)		
ϑ_j		+175 °C		
ϑ_a		-40 °C bis + 125 °C		

Statische Kennwerte ($\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5 \text{ K}$)

		SF 126	SF 127	SF 128	SF 129
U_{CBO}	(bei $U_{CB} = 33 \text{ V}$)	$\leq 100 \text{ nA}$	-	-	-
	(bei $U_{CB} = 66 \text{ V}$)	-	$\leq 100 \text{ nA}$	-	-
	(bei $U_{CB} = 100 \text{ V}$)	-	-	$\leq 100 \text{ nA}$	$\leq 60 \text{ nA}$
	(bei $U_{CB} = 120 \text{ V}$)	-	-	-	$\leq 1 \mu\text{A}$
I_{EBO}	(bei $U_{EB} = 7 \text{ V}$)	$\leq 1 \mu\text{A}$	$\leq 1 \mu\text{A}$	$\leq 1 \mu\text{A}$	$\leq 1 \mu\text{A}$
$U_{(BR)CEO}$	(bei $I_C = 50 \text{ mA}$)	$\geq 20 \text{ V}$	$\geq 30 \text{ V}$	$\geq 60 \text{ V}$	$\geq 80 \text{ V}$
U_{CEsat}	(bei $I_C = 150 \text{ mA}$, $I_B = 15 \text{ mA}$)	$\leq 0,5 \text{ V}$	$\leq 0,5 \text{ V}$	$\leq 0,5 \text{ V}$	$\leq 0,5 \text{ V}$

h_{21E} (bei $U_{CE} = 2 \text{ V}$, $I_C = 50 \text{ mA}$)	Gruppe A	18 ... 35
	B	28 ... 71
	C	56 ... 140
	D	112 ... 280
	E	224 ... 560
	F	450 ... 1 120

Dynamische Kennwerte ($\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5 \text{ K}$)

f_T (bei $U_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_C = 10 \text{ mA}$, $f = 15 \text{ MHz}$) $\geq 60 \text{ MHz}$